



## IRFP450: Mosfet N-Ch 500V 190W 14A



# Descripción

**Nombre:** MOSFET N-CH 500V 190W 14A **Referencia:** IRFP450

- Tipo de FET: MOSFET
- Polaridad de transistor: N
- Pd - Máxima disipación de potencia: 190 W
- |Vds| - Voltaje máximo drenador - fuente: 500 V
- |Vgs| - Voltaje máximo fuente - puerta: 20 V
- |Id| - Corriente continua de drenaje: 14 A
- Tj - Temperatura máxima de unión: 150 °C
- Rds(on) - Resistencia estado encendido drenaje a fuente: 0.40 Ohm

**Marca:** IR **Empaque:** TO-247-3 **Precio por:** Unidad **Ficha técnica:** [IRFP450](#)

## Información del producto

**Descripción:** MOSFET N-CH 500V 0.33W 14A. Marca: IR. Referencia: IRFP450 El IRFP450 es un MOSFET de potencia de canal N diseñado para aplicaciones de conmutación de alta velocidad y alta tensión. Es conocido por su baja resistencia en estado encendido y su capacidad para manejar corrientes elevadas, lo que lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones industriales y de potencia.

**Precio:** \$3.683 IVA INCLUIDO

**SKU:** 9-10-12

**Categorías:** [MOSFETS](#), [SEMICONDUCTORES](#)

**Etiquetas:** [0090010000012](#), [9-10-12](#), [datasheet](#), [IR](#), [IRFP450](#), [MOSFET N-CH 500V 0.33W 14A](#), [MOSFETS](#), [pinout](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#)



The image shows the datasheet for the IRFP450 MOSFET. It includes the International Rectifier logo, the part number IRFP450, and various technical specifications. Key parameters listed include V<sub>DS</sub> = 500V, R<sub>DS(on)</sub> = 0.40Ω, and I<sub>D</sub> = 14A. The datasheet also features a pinout diagram, a photograph of the component, and tables for Absolute Maximum Ratings and Thermal Resistance.

Parameter	Value	Unit
V <sub>DS</sub> - Drain-Source Voltage	500	V
I <sub>D</sub> - Drain Current (Continuous)	14	A
R <sub>DS(on)</sub> - Drain-Source Resistance	0.40	Ω
V <sub>GS</sub> - Gate-Source Voltage	20	V
T <sub>j</sub> - Junction Temperature	150	°C